

Cestelli Di Pulizia Per Wafer In Ptfе Personalizzati Portawafer In Silicio Per Semiconduttori Cassette In Fluoropolimero A Basso Fondo

Numero articolo: PL-CP266



introduzione

Cestelli di pulizia per wafer in PTFE personalizzati ad alta purezza per la lavorazione dei semiconduttori. Progettati per l'analisi in tracce a basso fondo e per la resistenza chimica agli agenti aggressivi, queste cassette su misura in fluoropolimero garantiscono zero dissoluzione e manipolazione senza contaminazione dei wafer di silicio in ambienti critici di camera bianca e laboratori industriali.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Pulizia RCA (SC-1/SC-2)	Rimozione di contaminanti organici, strati sottili di ossido e impurità ioniche dalle superfici in silicio.	Elevata resistenza alle miscele di perossido di idrogeno e idrossido di ammonio.
Incisione con acido fluoridrico	Rimozione selettiva di strati di biossido di silicio e passivazione superficiale.	Immunità completa all'HF, che altrimenti degraderebbe i portawafer in quarzo o vetro.
Lavorazione con incisione Piranha	Rimozione aggressiva di residui organici pesanti e fotoresist utilizzando acido solforico e perossido.	Mantiene l'integrità strutturale in ambienti altamente esotermici e ossidanti.
Supporto alla fotolitografia	Manipolazione dei wafer durante le fasi di sviluppo, rimozione e risciacquo dei materiali fotoresist.	La resistenza ai solventi garantisce che il portawafer non si gonfi o ammorbidisca quando esposto ai svernicianti.
Risciacquo post-CMP	Pulizia critica dei wafer dopo la planarizzazione meccanica-chimica per rimuovere le slurry abrasive.	La superficie a bassa generazione di particelle garantisce che i wafer rimangano puliti dopo la fase di lucidatura.
Preparazione di semiconduttori composti	Pulizia specializzata di wafer GaAs, GaN e InP per optoelettronica avanzata.	Il supporto delicato con fessure di precisione previene danni ai materiali composti fragili.
Pulizia ad ultrasuoni/megasonica	Pulizia con vibrazioni ad alta frequenza per rimuovere particelle submicroniche in acqua deionizzata.	Le proprietà del materiale smorzano le vibrazioni eccessive consentendo al contempo un efficace trasferimento di energia.

Categoria di parametro	Dettaglio specifiche per PL-CP266
Materiale primario	PTFE (Politetrafluoroetilene) / PFA (Perfluoroalossi) ad alta purezza
Metodo di produzione	Lavorazione CNC ad alta precisione (Fabbricazione su misura)
Compatibilità con dimensioni di wafer	Completamente personalizzabile (Dimensioni comuni: 2", 3", 4", 6", 8", 12" o dimensioni su misura)
Configurazione delle fessure	Spaziatura, profondità e quantità personalizzate in base alle richieste di processo
Progetto delle maniglie	Disponibili modelli fissi, rimovibili o anelli di sollevamento integrati (Personalizzabile)
Resistenza chimica	Eccellente (Compatibile con tutti gli acidi, le basi e i solventi organici)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Categoria di parametro	Dettaglio specifiche per PL-CP266	
Intervallo di temperatura di esercizio	-200°C a +260°C (Limite del materiale; specifico per l'applicazione)	
Ruvidità superficiale	Finitura CNC controllata per il minimo intrappolamento di particelle	
Fondo di elementi in traccia	Ottimizzato per analisi in traccia a basso livello (soddisfa le richieste di basso fondo)	
Profilo di dissoluzione	Zero dissoluzione / Nessun additivo lisciviabile (nessun rilascio in soluzione)	